공개특러 97-72358 1/2

☞대한민국특허청(KCR) ☞공 개 튝 허 공 보(A)

Dint. Cl. '
II 01 L 23/50

제 2658 호

❸공개인자 1997. 11. 7

❷출원일자 1996. 4. 1

⑪공개번호 **97**−72358 ⑫출원번호 96− 9774

심사경구 : 있음

⑰ 말 명 자 히 영 욱 경기도 성난시 분당구 수내동 55 롯데이과트 132·1504

☞ 출 원 인 아님산업 무식회사 대표이사 황 인 신

서울특별시 성동구 성수 2가 280-8 (우: 133-120)

M 대리인 변리사 서 만 규

(전 2 면)

❷ 반도체패키지의 제조빙법 및 구조

89 명 하

돈 발명은 반도체폐키지의 제조방법 및 구조에 관한 것으로, 반도체침의 저면을 외부로 노출시켜 회보통작시 발생되는 얼당출의 효과를 국대화하여 패키지의 수명을 연장시키고, 신의성을 항상시집은 불론, 패키지의 목당 부 외축에 위치한 리드는 절단하고, 골딩부 내축에 위지한 비드는 그 처면은 외무로 노출시켜 마디보드에 실장 서 리드의 저면에서 신호전달을 하도록 함으로서 실장면적을 최소할 수 있는 반도체패키시이다. 공개륙터 97-72358 2/2

특허청구의 범위

- 1. 디수의 리트가 형성되고, 상기 다수의 리트 중앙부에는 철탑재판이 없는 리트프레임을 형성하는 단계와: 상기 리트프레임의 다수의 리트 중앙부에 만도체임을 위치시켜 와이어본당을 실시하는 단계와: 상기 와이어본 당된 리트, 반도체험 및 와이어를 외부의 산회 및 부식으로부터 보호하기 위하여 문당하는 단계와: 상기 단계 후에 물당영역 의가에 위치한 리트를 절단하는 단계로 이두어진 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
- 2. 제1항에 있어서, 상기 와이어본당은 배출 홀(Vacuum Hole)이 형성된 히더블릭에 반도체험을 위치시켜 상기 배경 춤로 공기를 빨아들여 반도체험을 지지 고정하는 것을 특징으로 하는 반도체패키자의 제조방법.
- 3. 계1항에 있어서, 상기 불당단계는 액상 봉지재를 사용하여 몰당하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제소방법.
- 4. 제1형 또는 3항에 있어서, 액상 봉지재를 시용하여 물당하기 전에 물당영역에 단을 형성하여 액상 봉지재가 끝리 넘치는 것을 받지하는 것을 특징으로 하는 반노재패키지의 제조방법.
- 5. 세1항에 있어서, 삼기 골딩단자는 물드 컴파운드를 사용하여 돌덩하는 것을 특징으로 하는 반도쇄패키지의 제조방법.
- 6. 제3합 또는 5항에 있어서, 상기 액상 봉지재 및 골드 경파운으로 몰딩 후, 150℃ 이상의 고은에서 수시킨 노출시켜 경화시키는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
- 7. 제1항에 있어서, 상기 반도체때키지의 저면에는 그라인드(Grind)를 실시하여 플래쉬(Plash)를 제거하는 것을 특징으로 하는 만노계패키지의 제조합법.
- 8. 제1함에 있어서, 생기 몰딩영역의 외각에 위치한 리드를 절단시 절단은 용이하게 하기 위하여 절단되는 부위의 리드에 노치(Notch)들 형성한을 특징으로 하는 반노제대키지의 제조방법.
- 9. 서년이 외부로 직접 노출되는 반도체칭과; 상기 반도체칭의 외축에 위치되고 물명영역을 벗어나지 않으며 지면이 외부로 노출되어 저면에서 진호의 입출력이 이루어지는 다수의 리드와: 상기 반도체칭과 리드를 면결시 켜주는 와이어와; 상기 반도체칭, 리드 및 와이어를 외부 환경으로부터 보호하기 위하여 물명된 액상 붕지재 또는 컴파운드로 구성된 것을 특징으로 하는 반도체회기지의 구조.
- 10. 제9항에 있어서, 상기 몰딩된 역상 통지대 및 컨피운드는 리드 및 반도체집의 상부로만 골딩된 것을 복장으로 하는 반도체패키지의 구조.
- 11. 제9밖에 있어서, 상기 반도채패키지의 자연에는 플레쉬(Flash)의 제거를 위해 그라인트(Grind) 된 것을 록정으로 하는 반도체패키지의 구조
- 12. 제9항에 있어서, 리드프레임의 나수의 리드 중앙부에는 침탑재판이 없는 것을 목정으로 하는 반도체패키 지의 구조.

※ 참고사항: 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면의 간단한 설명

